SU 8806283



АКАДЕМИЯ НАУК УССР

ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Препринт КИЯИ-86-43

Kiyi -- 86-43

and the state of the

Ю.Г.Здесенко, В.И.Третяк

РАСЧЕТ ПО МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО УГЛОВЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЭЛЕКТРОНОВ, ПРОШЕДШИХ ЧЕРЕЗ СЛОИ ВЕЩЕСТВА (программа TRACK)

КИЕВ

УДК 539.124.17

Ю.Г.Здесенко, В.И.Третяк

РАСЧЕТ ПО МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО УГЛОВЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЭЛЕКТРОНОВ, ПРОШЕЩИИХ ЧЕРЕЗ СЛОИ ВЕЩЕСТВА (программя TRACK)

Разработана программа, которая позволяет моделировать процессы взаимодействия электронов с веществом и может быть использована при планировании и проведении исследований 2 β -распада атомных ядер с целью оптимизации экспериментальных методик и для обработки результатов измерений.

При расчете энергетических потерь электронов учитываются неупругие столкновения с атомными электронами среды, вызывающими возбуждение или ионизацию атомов (ионизационные потери), а также тормозное излучение, возникающее при ускорении электронов в электрических полях атомных ядер и оболочек (радиационные потери).

Проверка программы на экспериментальных данных показала ее применимость в широком диапазоне толщин и атомных номеров поглотителей.

A programme is worked out allowing to model the processes of electron interaction with substance and may be used at planning and making investigations of double-beta decay of atomic nuclei to optimize the experimental procedures and to analyse the measurement results.

On calculation the energy losses of electrons the nonelastic collisions are taken into consideration with atomic electrons of medium causing the excitation and atom ionisation (ionisation losses) and also the bremsstrahlung occurred at electron acceleration in electric fields of atomic nuclei and shells(radiation loss).

A programme control on experimental data showed its applicability within the wide range of thicknesses and atomic numbers of absorbers.

> The calculation of angular and energy distribution of electrons, passed through the substance layers by Monte-Carlo method, (TRACK programme)

Yu.G.2desenko, V.I.Tretyak Печатается по постановлению Ученого совета Института ядерных исследований АН УССР АКАЛЕМИЯ НАУК УССР

Ю.Г.Здесенко, В.И.Третяк

РАСЧЕТ ПО МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО УГЛОВЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЭЛЕКТРОНОВ, ПРОШЕДШИХ ЧЕРЕЗ СЛОИ ВЕЩЕСТВА (программа TRACK)

Введение

Прямые эксперименты по изучению 26 -распада атомных ядер основаны на непосредственной регистрации излучаемых в этом процессе электронов. Исследуемые нуклиды могут быть распределены в детекторе гомогенно, т.е. входить в состав рабочей среды детектора, или гетерогенно- в виде внешних по отношению к детектору образцов конечной толщины. В последнем случае корректная интерпретация экспериментальных результатов возможна только при тщательном учете процессов взаимодействия электронов с веществом образца, приводящим к потерям энергии и отклонению электронов от первоначального направления движения. Указанные эффекты могут вызывать искажение исходных энергетических и угловых распределений электронов и уменьшать эффективность регистрации в детекторе событий 26-распада.

Описываемая в настоящей работе программа позволяет моделировать процессы взаимодействия электронов с веществом и может быть применена при обработке результатов исследований 23-распада, а также других опытов, связанных с прохождением электронов через плотную среду.

I. Взаимодействие электронов с веществом

Электроны, двигаясь через вещество, теряют энергию и изменяют направление своего движения. Потери энергии происходят в неупругих столкновениях с атомными электронами среды, вызывающими возбуждение или ионизацию атомов (так называемые ионизационные потери), а также за счет тормозного излучения, возникающего при ускорении электронов в электрических полях атомных ядер и оболочек (радиационные потери). Нарушение прямолинейности движения электронов обусдовлено соударениями с атомами среды и вызывает дополнительное увеличение энергетичес-

З

ких потерь за счет удлинения проходимого в веществе пути.

I.I. Многократное кулоновское рассеяние электронов

Возможны два подхода к моделированию прохождения электронов через вещество. Первый из них основан на разыгрывании каждого элементарного акта взаимодействия электрона с ядрами и электронными оболочками атомов среды и требует поэтому больших затрат машинного времени. Более экономичный способ состоит в том, что пройденный электроном путь разбивается на "элементарные" участки, длина которых в десятки или даже сотни раз превышает средний пробег между двумя последовательными соударениями, а координаты и энергия электронов на выходе из каждого участка вычисляются или разыгрываются по их входным значениям в соответствии с теориями, описывающими поведение электронов в слоях вещества конечной толщины.

В настоящей работе использован метод разбиения траектории на участки, а описание движения электронов в "элементарном" слое вещества основано на теории многократного кулоновского рассеяния, развитой в работах Мольера/I/, Гаудсмита и Саундерсона /2/, а также Бете /3/.

Согласно Мольеру/I/ плотность вероятности $\mathcal{D}^{(\theta)}$ отклонения электронов на угол θ от первоначального направления движения после прохождения слоя вещества толщиной ℓ определяется разложением:

$$\begin{split} \mathcal{P}^{n}(\theta) &= \frac{1}{\chi_{c}^{2}B} \left\{ 2e^{-\delta_{+}^{2}} \frac{f_{z}(\delta)}{B} + \frac{f_{z}(\delta)}{B^{2}} + \cdots \right\}, \quad (1) \\ f_{n}(\delta) &= \frac{1}{n!} \int_{0}^{\infty} \mathcal{U}_{0}^{1}(\delta u) e^{-\frac{2u}{4}} \left(\frac{u^{2}}{4} \ln \frac{u^{2}}{4} \right)^{n} du, \quad (2) \\ \delta &= \theta / \chi_{c} \sqrt{B}, \quad (3) \end{split}$$

Г(би) - функция Бессеня.

Первый член ряда (I) представляет собой гауссиан с дисперсией $\chi_c^2 B/2$ и определяет многократное рассеяние на малые углы, а члены более высокого порядка дают поправки на одиночное и кратное рассеяние. Мольеровский угол χ_c^2 является мерой среднеквадратичного отклонени: электрона от первоначального направления после прохождения слоя веще-, ства ℓ и вычисляется следующим образом:

 $\chi_{c}^{2} = 4_{TT} \cdot N_{A} \cdot e^{4 \frac{\mathcal{I}(\mathcal{I}+1) \mathcal{O} \cdot l}{A \cdot F (E+2m_{b}C^{2}) \mathcal{G}^{2}}} = 1569/4, 9 \frac{\mathcal{I}(\mathcal{I}+1) \mathcal{O} \cdot l}{A \cdot E(E+2m_{b}C^{2}) \mathcal{G}^{2}} \rho_{a} \partial^{2} (4)$

где E - кинетическая энергия электрона, кэВ; ρ - плотность вещества, г/см³; ℓ - толщина слоя, см; A, Z - етомная масса и атомный номер среды; $M_0 C^2 = 511,0034$ кэВ - масса электрона; $NA = 6,022045 \cdot 10^{23}$ моль⁻¹ - число Авогадро; $e = 4,803242 \cdot 10^{-10}$ см^{3/2} · г^{1/2} · с⁻¹ - заряд электрона;

$$\beta^{2} = \sqrt{2}/C^{2} = 1 - 1/(1 + E/m_{o}C^{2})^{2};$$

V, C - скорости электрона и света соответственно. Величина В в (I) находится из решения уравнения

$$B - lnB = ln(\chi_c^2/\chi_s^2) + 1 - 2C,$$
 (5)

где C = 0,5772157 - постоянная Эйлера, а χ_9 - так называемый критический угол, ограничивающий (из-за экранирования поля ядра полем электронных оболочек) минимальное отклонение, которое электрон может получить в единичном акте рассеяния. Отношение χ_2^2/χ_9^2 представляет по своему физическому смыслу

Отношение χ_{c}/χ_{c} представляет по своему физическому смыслу среднее число актов столкновений в слое вещества толщиной ℓ :

$$\frac{\chi_{c}^{2}}{\chi_{3}^{2}} = \frac{4\pi N_{A}}{A} \left(\frac{\hbar}{m_{b}c}\right)^{2} \frac{\mathcal{I}^{4}(\mathcal{I}+1)\rho \cdot l \cdot O,885^{2}}{\beta^{2}(1,13+3,76\alpha^{2})} = 7821,579 \frac{\mathcal{I}^{4}(\mathcal{I}+1)\rho \cdot l}{A \cdot \beta^{2}(1+3,327433c^{2})}, (6)$$

где $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{o} = \mathcal{I}/\mathcal{J}^{3}$, а $\mathcal{L}_{o} = I/I37,0364$ - постоянная тонкой структуры.

В программе уравнение (5) решается методом Ньютона-Рафсона. Функция $\rho^{\prime\prime}(\theta)$ при $\delta < 10$ находится по разложению (1), где оставлены первые три члена (остальные дают поправку менее 1%). Первый член вычисляется аналитически, второй и третий – путем линейной интерполяции табличных эначений, приведенных в /3/. При $\delta \ge 10$ для нахождения $\rho^{\prime\prime}(\theta)$ применяется асимптотическая формула /3/:

$$\rho^{(n)}(\theta) = \frac{2\chi_{c}^{2}/\theta^{4}}{1 - \frac{4}{5^{2}}\left(1 + \frac{2\ln(0, 45)}{B}\right)}$$
(1-A)

Плотность вероятности (I) была получена Мольер[№] предположении о малости углов рассеяния и применима до $\Theta \sim 30^{\circ}$. Гаудсмит и Саундерсон /2/ развили теорию, справедливую для любых углов, но в вычислительном плане она значительно превышает по трудоемкости теорию Мольера.Однако Бете /3/ удалось достаточно просто и с хорошей точностью выразить распределение Гаудсмита и Саундерсона $\rho^{es}(\Theta)$ через функцию Мольера: $\rho^{es}(\Theta)$:

$$\rho^{\text{GS}}(\theta) = \rho^{\text{M}}(\theta) \cdot \sqrt{\frac{\theta}{\sin\theta}} \cdot \exp\left(\frac{\chi_{0}^{*}B}{16}\right) + \frac{1}{24} \qquad (7)$$

В работе /2/ при вычислении функции $\rho^{e_{i}}$ рассматривается не толщина слоя ρl , а действительная длина пути ρJ , пройденного электроном в слое вещества. Благодаря изломанности траектории ρJ всегда больше ρl и является случайной величиной. Плотность распределения приращения длины

$$\Delta = (\rho L - \rho l) / X_{r} \tag{8}$$

установлена в работе Янга /4/:

$$p(A) = 2 \left(\frac{\omega X_r}{ge}\right)^2 \cdot Q(q), \qquad (9)$$

$$q = 2A \left(\frac{\omega X_r}{ge}\right)^2;$$

где

$$w = 2p \cdot c \cdot g / (m_0 c^2 \sqrt{4\pi/66}) = \sqrt{\frac{2}{37}} g \sqrt{c(c+2)} = 4,81955 7 \cdot 10^{-2} g \sqrt{c(c+2)};$$

Х- - радиационная длина

Xr = (41, e" NA = ln(183) = 716,4223 A Xr = (41, em e (1/2) + ln(183) = 716,4223 A Z (5,200788 - 1 (1, 2) + (10)

· ·····

 ρ - импульс электрона, а функция Q(q) с точностью до 1% может быть выражена в виде

$$Q(q) = \begin{cases} \frac{2}{47} q^{-\frac{3}{2}} \left(e^{-\frac{1}{4}} - 3e^{-\frac{1}{4}} \right), & q \le 2\\ \frac{2}{47} e^{-\frac{37}{26}}, & q > 2 \end{cases}$$
(11)

Найденная в соответствии с (8-II) действительная длина пути электрона ρL используется затем для вычислений угловых отклонений.

I.2. Потери знергии на ионизацию и возбуждение атомов среды

В соответствии с теорией Ландау /5/ плотность распределения ионизационных потерь энергии $\Delta \mathcal{E}_{4}$ электрона при прохождении в веществе пути $\rho \mathcal{L}$ равка

$$\mathcal{P}(\Delta E_u) = \frac{1}{F} \mathcal{P}(\mathcal{X}), \qquad (12)$$

где

$$\varphi(\Lambda) = \frac{1}{2\pi i} \int exp(ulnu+\Lambda u) du, \quad (13)$$

$$\lambda = \frac{\Delta E_{u}}{\gamma} - \ln \left(\frac{F_{u} - 2m_{0}c^{2}\beta^{2}}{(1-\beta^{2})I^{2}} - 1 + (+\beta^{2} + \delta) \right)$$
(14)

$$\xi = \frac{2\pi N_{A} \cdot e^{4}}{m_{o} c^{2}} \cdot \frac{\overline{z} \cdot p \cdot L}{A \beta^{2}} = 153,5360 \frac{\overline{z} \cdot p L}{A \beta^{2}}, ** \theta \cdot (15)$$

С – постоянная Эйлера; I – средний потенциал ионизации, кэВ; б – поправка, учитывающая эффект поляризации среды при прохождении через нее заряженной частицы.

Подробные таблицы значений функции Ландау $\mathcal{P}(\mathcal{A})$ представлены в работе /6/, а удобные формулы для аппроксимации $\mathcal{P}(\mathcal{A})$ и функции, обратной к интегралу от $\mathcal{P}(\mathcal{A})$, получены в /7/.

В распределении Ландау (I3) не приняты во внимание резонансные эффекты передачи энергии электронным оболочкам атомов среды. В /8/ показано, что эти эффекты могут быть учтены путем свертки распределения (I3) с гауссианом

иде в
$$\frac{1}{B\sqrt{T}} CXP(-\lambda^2/B^2)$$
, (16)
иде в - так называемий "резонансный" фактор
 $B^2 = 2 \cdot 10^{-2} \cdot \mathcal{I}^{\frac{4}{3}} \frac{\Lambda E_4}{\xi^2}$, (17)

а *ДСи –* средние потери энергии на ионизацию, определнемые модифицированной формулой Бете-Блоха

$$\overline{\Delta E_{u}} = \left\{ \left(\ln \frac{\mathcal{E}^{2}(\mathcal{E}+2)}{2(I/m_{o}C^{2})^{2}} + \frac{1 + \mathcal{E}^{2}/8 - (2\mathcal{E}+1)\mathcal{E}n^{2}}{(\mathcal{E}+1)^{2}} - \delta \right), (18) \right\}$$

$$\mathcal{E} = E/m_{o}C^{2}. \qquad (19)$$

В связи с трудностями, возникающими при выполнении свертки распределения (13) с гауссианом (16), Блунк и Лейзеганг /8/ предложили аппроксимировать функцию Ландау суммой четырех гауссианов, каждый из которых легко может быть свернут с (16). Финдлей и Дюсотой /9/ улучшили аппроксимацию $\varphi(\Lambda)$, увеличив число гауссианов до девяти, и получили после свертки следующее выражение

$$\varphi(\mathcal{R}) = \sum_{i=1}^{9} \frac{c_i \, \mathscr{V}_i}{(\mathscr{S}_i^2 + \mathscr{B}^2)^{4_{2}}} \, \mathcal{C} \mathcal{X} \, \rho \left[-\frac{(\mathcal{R} - \mathcal{X}_i)^2}{\mathscr{S}_i^2 + \mathscr{B}^2} \right]. \tag{20}$$

Значения коэффициентов C_c , λ_c , λ_c , λ_c , для вычисления (20) приведены в табл. I, взятой из /9/. Вид (17) и (20) показывает, что резонансные эффекты передачи энергии особенно существенны для тонких слоев и приводят к смещению максимума распределения конизационных потерь и увеличению его дисперсии.

Поляризационные явления, возникающие при прохождении электронов через плотную среду, наоборот, вызывают уменьшение ионизационных потерь. Так, для электронов с энергией 2 МэВ это уменьшение составляет 6,1% в графите и 3,6% в золоте /IJ/. Поляризационный эффект учитывается с помощью члена б, входящего в (I4) и (I8). Процедура точного расчета величины б, зависящей ст энергии электронов и параметров среды, описана, например, в работах /I0, II/. Она является довольно громоздкой, в связи с чем предпочтительнее пользоваться следующими аппроксимационными формулами /I0/:

, see

i	Ci	λι	Yı
I	0,0368	-1,480	0,737
2	0,0843	-0,738	0,947
3	0,0882	0,170	1,23
4	0,0647	1,33	I,68
5	0,0359	2,95	2,40
6	0,0164	5,39	3,68
7	0,0064	9,40	6,18
8	0,0021	16,8	12,3
9	0,0006	30,8	39,7

Коэффициенты для аппроксимации функции Ландау 9 гауссианами

Таблица 2

Значения параметров для расчета поляризационных эффектов

.

Вещество	2	- G.	X.	Χ.	a	m	8.
Алюминий	13	4,2395	0,1708	3,0127	0,08024	3,6345	0,12
Кремний	I4	4 , 435I	0,2014	2.8715	0,14921	3,2546	0,14
Медь	29	4,4190	-0,0254	3,2792	0,14339	2,9044	0,08
Германий	32	5,1411	0,3376	3,6096	0,07188	3 ,33 06	0,14
Молибден	42	4,8793	0,2267	3,2784	0,10525	3,2549	0,14
Серебро	47	5,0630	0,0657	3,1074	0,24585	2,6899	0,14
Золото	79	5, 5747	0,2021	3,6979	0,09756	3,1101	0,14
Свинец	82	6,2018	0,3776	3,8073	0,09359	3,1608	0,14

$$\begin{aligned}
\delta(x) &= \begin{cases}
0, & x \leq x_0 & \partial_{x_1} & Henpollo \partial_{HUMOB} \\
\delta_0 \cdot 10^{2(x-x_0)}, & x \leq x_0 & \partial_{x_1} & npollo \partial_{HUMOB} \\
& x \cdot 2 \ln 10 + \alpha (x_1 - x)^m + G_0, & x_0 < x < x_* & (21) \\
& x \cdot 2 \ln 10 + G_0, & x_0 < x < x_*, \\
& x \cdot 2 \ln 10 + G_0, & x_0 < x_1,
\end{aligned}$$

Fige $X = lg p/m_0 c = \frac{1}{2} lg \{ E(E+2) \}^2.$

Коэффициент G_0 зависит от характеристик среди, в S_0, X_0, X_1, q_1 явилотся подгоночными параметрами и вычислены в /II/ на основе m точной процедуры расчета $\delta(E)$. Значения этих параметров для некоторых Z приведены в табл. 2.

1.3. Радиационные потери энергии

В работе /12/ показано, что полные радиационные потери ΔE_{ρ} энергии, возникающие при ускорении электронов в кулоновских полях ядер и электронных оболочек атомов, могут быть описаны для тонких слоев формулой:

$$\Delta E_{p} = \rho L_{d_{0}} \left(\frac{e^{2}}{m_{o}c^{2}} \right)^{2} N_{A} \cdot \frac{\mathcal{Z}}{A} \left(E + m_{o}c^{2} \right) \Psi \left(E, \mathcal{Z} \right) =$$

$$= 3,489562 \cdot 10^{-4} \frac{\mathcal{Z}^{2} \rho L}{A} \left(E + m_{o}c^{2} \right) \Psi \left(E, \mathcal{Z} \right), \times \mathcal{B} (22)$$

где безразмерная функция Y(E, Z) выражает остаточную зависимость потерь от Е и Z. Для Z от I до 100 и энергий от 3 кэВ до ІО ГЭВ эта функция аппроксимируется с погрешностью менее 1% таким выражением

$$\Psi(E, \underline{z}) = d_{z}(\underline{z}) \left[1 + \sum_{i=z}^{z} f_{i}(\underline{z}) (l_{n} E)^{i} \right] / \left[1 + \sum_{i=z}^{z} h_{i}(\underline{z}) (l_{n} E)^{i} \right],$$
(23)
¹ Че Е выражено в МаВ.

Значения коэффициентов da, fc, hc вычислены в /12/ и для некоторых веществ представлены в табл. З. В качестве примера укажем, что доля потерь на тормозное излучение электронов с начальной энергией 2 МэВ, полностью затормозившихся в веществе, составляет в алюминии I.45%, а в свинце - IO.8%.

Таблица З

Козффициенты для вычисления радиационных потерь энергии

.

.

Вещество	Z	di	I0 (,	10 [2	100 (s	1000 {.	IO h.	1042	100 h3	1000 h _y
Алюминий	13	6,4185	3,7066	2,0450	2,8750	1,0984	I,0366	0,6827	0,7722	0,5543
Кремний	I4	6,4158	3.7512	2,0792	2,9122	1,1044	1,1117	0,7045	0,7656	0,5828
Медь	29	6,5754	3,9824	2,2837	3,7519	1,8370	1,8107	0,9027	I,0495	1,0547
Германий	32	6,6321	3.9452	2,1610	3,6100	1,8205	1,8973	0,8591	1,0309	1,0752
Молибден	42	6,8II4	3,7627	2,1018	3,5145	1,7186	1,9752	0,9314	0,9992	1,1314
Серебро	47	6,9039	3,6530	2.0525	3,4650	1,6919	1,9877	0,9548	0,9977	1,1577
Золото	79	7,5133	2.2935	1,2341	2,4982	1,4316	1,3792	0,7574	0,8551	I,II99
Свинец	82	7,5720	2,0234	1,1091	2.3613	1.4037	1,1764	0,7059	0,8275	I.0978

an an

I.4. Обратное рассеяние электронов от детектора

При построении функции отклика детектора и определении эффективности регистрации важное значение имеет учет обратного отражения электронов от детектора. Коэффициент обратного рассеяния электронов от толстых слоев вещества зависит от \varkappa , энергии и угла падения θ . Кузъминых и Воробьев /13/ выразили эту зависимость в виде

$$\mathcal{J}(\mathcal{I}, \mathcal{E}, \theta) = k \cdot \theta^{\alpha} + \mathcal{J}(\mathcal{I}, \mathcal{E}, \theta), \qquad (24)$$

где $\mathcal{J}(\mathcal{I}, \mathcal{E}, \mathcal{O})$ - коэффициент отражения для случая нормального падения электронов, который определен в работе /14/

$$\begin{array}{l}
 y(\Xi, E, 0) &= \alpha_{I}/(I + \alpha_{2} E^{\alpha_{3}}), \\
 rae & \alpha_{I} &= b_{I} exp(-b_{2} Z^{-b_{g}}), \\
 \alpha_{2} &= b_{4} + b_{5} Z^{-b_{6}}, \\
 \alpha_{3} &= b_{7} - b_{8}/Z.
 \end{array}$$
(25)

Постоянные β_{L} приведены в табя. 4, которая позаимствована из /14/. Коэффициенты K и d, зависящие от Z и E, вычислены для некоторых поглотителей и энергий в работе /13/ и представлены в табя. 5.

2. Геометрия движения электронов

Основная система координат, которая используется в программе для построения траектории электронов, а также возможное расположение образца и детекторов изображены на рис. І. Начало системы координат O_0 зафиксировано в центре плоско-параллельного образца, а ось $Q \neq$ перпендикулярна его основанию. Направление движения электрона в произвольной точке траектории F характеризуется углами O и P.

Угловые отклонения, испытываемые электроном при прохождении " "элементарного" слоя, наиболее просто вычислять в системе координат, начало O_{L}^{*} которой расположено в точке вхождения электрона в очередной слой L, а ось O_{L}^{*} Ξ направлена по вектору скорости частицы. В связи с этим в программе введена последовательность таких координатных систем O_{L}^{*} (рис. 2) и разработана процедура пересчета углов и

Таблица 4

Параметры для определения коэффициента отражения электронов при нормальном падении

6,	62	6,	64	l _s	le	63	6.	
I,15	8,35	0,525	0,0185	15,7	1,59	1,56	4,42	

Таблица 5

Значения параметров для расчета коэффициента отражения электронов при произвольном угле педения

Велество	3		Энергия, кэВ			
	-		500	1000	2000	
Алюминий	13	k d	0,209 2,118	0,211 2,174	0,203 2,258	
Медь	29	k d	0,186 1,982	0,200 2,000	0,209 2,044	
30 201 0	79	k d	0,112 1,901	0,127 1,901	0,148 1,923	
Свинец	82	k đ	0,112 1,935	0,125 1,919	0,148 1 ,92 6	

time to the second s



Рис. I. Основная система координат и возможное расположение образца и детекторов



Рис. 2. Последовательность систем координат для моделирования траектории электрона

STAR

координат в якбой из систем О2 к фиксированной системе О6 .

Рассмотрим движение электрона, который излучен из точки O_4 в направлении Θ_{21} , Θ_1 (здесь и в дальнейшем первый индекс в обозначениях углов и координатных векторов указывает систему, в которой они измерены, а второй – порядковый номер точки O_2). После прохождения расстояния $O_4O_2 = \rho l$ электрон получает отклонение, которое в системе O_4 выражается углами Θ_{22} , Θ_{42} . Известны также координаты \overline{A}_2 точки O_2 в системе O_4 : $\overline{A}_2 = (\frac{B}{B_2})$.

Координаты $\overline{\mathcal{L}_{22}}$ точки \mathcal{D}_2 в системе \mathcal{D}_0 связаны с $\overline{\mathcal{L}_{22}}$ соотношением

$$\overline{F}_{02} = \overline{F}_{01} + A_{01} \cdot \overline{F}_{12}, \qquad (26)$$

í

где A_{01} - матрица преобразований, позволяющая по координатам частицы в системе O_2 вычислить координаты в системе O_0 . Для получения ориентации системы O_1 систему O_0 нужно повернуть на угол Y_{02} вокруг оси $O_0 \neq$, а затем на угол O_{01} вокруг оси $O_0 \neq'$, что и определяет вид матрицы A_{01}

$$A_{01} = \begin{pmatrix} \cos \theta_{01} & \cos \theta_{01} & -\sin \theta_{01} & \sin \theta_{01} & \cos \theta_{01} \\ \cos \theta_{01} & \sin \theta_{01} & \cos \theta_{01} & \sin \theta_{01} & \sin \theta_{01} \\ -\sin \theta_{01} & 0 & \cos \theta_{01} \end{pmatrix}$$
(27)

Соотношение (26) справедливо для любой точки От, т. е.

$$\overline{F}_{om} = \overline{F}_{o1} + A_{o1} \cdot \overline{F}_{im}. \qquad (28)$$

На следующем шаге электрон оказывается в точке O_{3} с координатами $\widetilde{N_{23}}$. Переход к системе O_{4} осуществим по аналогии с (26)

$$\overline{F}_{23} = \overline{F}_{12} + A_{12} \cdot \overline{F}_{23},$$
 (29)

а затем, используя (28), найдем координаты Оз в системе Оо

Продолжая эти вычисления для последующих точек, получим, что на шаге m+1 координаты точки O_{M+M} в системе O_O находятся так:

B (30) BCE VIREHEN
$$\overline{f_{e,\mu,\mu}}$$
 UNMERT BUR $\begin{pmatrix} g_{e} \\ g_{e} \end{pmatrix}$, a

$$A_{i,i+i} = \begin{pmatrix} \cos \theta_{i,i+i} \cos \theta_{i,i+i} & -\sin \theta_{i,i+i} & \sin \theta_{i,i+i} \cos \theta_{i,i+i} \\ \cos \theta_{i,i+i} \sin \theta_{i,i+i} & \cos \theta_{i,i+i} & \sin \theta_{i,i+i} \\ -\sin \theta_{i,i+i} & 0 & \cos \theta_{i,i+i} \end{pmatrix}$$
(31)

С другой стороны, аналогично (28) можно записать, что

$$\overline{F_{0,M+1}} = \overline{F_{0M}} + A_{0M} \cdot \overline{F_{M,M+1}}, \qquad (32)$$

где Аом характеризует направление скорости частицы в точке От :

Сравнивая (30) и (32), получаем, что

NILN

Вычисляя по мере продвижения электрона матрицу *Aom* с помощью (34) и приравнивая ее^и правой части выражения (33), можно однозначно определить углы *Bom*, *Yom*, характеризующие направление движения частицы на выходе из произвольного слоя в координатной системе *O*. Аналогично соотношение (30) позволяет выразить координаты любой точки траектории электрона в исходной системе координат.

Примечание. Направление движения частицы можно характеризовать тремя направляющими косинусами $Cos \ll_{r, s', t'}$, равными проекциям единичного вектора скорости на соответствующие оси. Выразим, используя развитый выше формализм, косинусы $Cos \ll_{r, r, t'}$ на входе в (22) слой через косинусы $Cos \ll_{r, r, t'}$ предыдущего слоя и полученные в нем отклонения $\Theta_{i, i' t'}$, $V_{i, i' t'}$. Поскольку в правой декартовой системе координат De les services d'activités and a construction de la construction de la construction de la construction de la c

$$\cos d_{x}^{i+i} = \cos \theta_{0,i+i} \cdot \sin \theta_{0,i+i}$$

 $\cos d_{y}^{i+i} = \sin \theta_{0,i+i} \cdot \sin \theta_{0,i+i}$
 $\cos d_{x}^{i+i} = \cos \theta_{0,i+i}$

для решения этой задачи необходимо вычислить матрицу $A_{0,i+i}$ (33), характеризующую в системе O_0 направление скорости в точке O_{i+i} углами $O_{0,i+i}$; $Y_{0,i+i}$. В соответствии с (34)

где Аог, А с, ст. имеют вид (ЗІ). Выполнив умножение и взяв соответствующие члены результирующей матрицы, получим:

$$Cosod_{x} = losod_{x} los \theta_{i,i+1} + \frac{Sin\theta_{i,i+1}}{\sqrt{I-Cosod_{x}}} \left(losd_{x} losod_{x} lost_{i,i+1} - losd_{y} Sin f_{i,i+1} \right),$$

$$Cosod_{y} = losd_{y} los \theta_{i,i+1} + \frac{Sin\theta_{i,i+1}}{\sqrt{I-Cosod_{x}}} \left(losd_{y} losd_{x} lost_{i,i+1} + losd_{x} Sinf_{i,i+1} \right),$$

$$Cosod_{y} = losd_{y} los \theta_{i,i+1} + \frac{Sin\theta_{i,i+1}}{\sqrt{I-Cosod_{x}}} \left(losd_{y} losd_{x} lost_{i,i+1} + losd_{x} Sinf_{i,i+1} \right),$$

$$Cosod_{y} = losd_{y} los \theta_{i,i+1} + \sqrt{I-Cosod_{x}} \cdot Sin\theta_{i,i+1} + losd_{y} Sinf_{i,i+1} \right),$$

Эти выражения с точностью до обозначений совпадают с формулами преобразований направляющих косинусов, приведенными, например, в работе /15/.

3. Порядок работы программы

Для выполнения моделирования необходимо ввести следующие исходные данные:

3.1. Форма и размеры образца, детектора и их взаниное расположение;

3.2. Плотность, атомная масса, атомный номер образца и детектора;

3.3. Координаты \mathcal{F} точечного источника электронов или распределение вероятностей $\mathcal{P}(\mathcal{F})$ излучения электронов в заданном объеме « пространства;

3.4. Исходные углы ими распределение вероятностей $\mathcal{P}(\theta)$, $\mathcal{P}(\theta)$ излучения электронов источником в заданном интервале углов θ, φ ;

3.5. Начальная энергия электронов E или распределение вероятностей $\Phi(E)$ испускания электронов в зависимости от энергии;

3.6. Толщина "элементарного" слоя или число столкновений в "элементарном" слое или относительная доля энергии, которую электрон теряет в "элементарном" слое;

3.7. Аппаратурная функция отклика детектора при регистрации моноэнергетических электронов ваданном интервале энергий $\mathcal{D}(\mathcal{C},\mathcal{E})$;

3.8. Энергетическая калибровка детектора, а также начальный и конечный номера каналов, в которых будет моделироваться спектр;

3.9. Число /7 разыгрываемых событий и два числа, служащих базой счетчика случайных чисел.

Распределения вероятностей по пунктам 3.3 - 3.7 могут быть заданы формулами, таблицами или в алгоритмическом виде.

Кроме перечисленных начальных условий, необходимо указать, для каких частиц – прошедших через образец или отраженных от него, – будут рассчитываться угловые и энергетические распределения.

Моделирование каждого из событий осуществляется программой в следующей последовательности

3.10. Разыгрываются координаты точки вылета электрона в соответствии с распределением $\Phi(\mathcal{P})$, заданным в пункте 3.3;

3.11. Разыгрываются углы вылета θ_{01} , θ_{11} электрона из источника по распределениям $\Phi(\theta)$, $\Phi(P)$ из пункта 3.4;

3.12. Разыгрывается значение начальной энергии электрона на основе распределения $\Phi(\mathcal{E})$, заданного в 3.5;

3.13. Вычисляются координаты вхождения электрона в образец в случае, если источник электронов расположен вне образца;

3.14. На основе данных по пункту 3.6 определяется толщина "элементарного" слоя pl . Электрон, находящийся у границы образца, может до выхода из него пройти путь, меньший pl . В этом случае толщина "элементарного" слоя принимается равной реальному пути;

3.15. В соответствии с распределением (9) разыгрывается действительное значение длины пути ρZ , проходимого электроном в "элементарном" слое;

3.16. На основе распределения (7) разыгрывается угол \mathcal{O}_{i} , на который отклонится электрон после прохождения \dot{z} - го слоя;

3.17. Разыгрывается значение угла $\mathcal{P}_{2,2,1}$, который считается равномерно распределенным в интервале $[0, 2\pi]$;

Поскольку распределение (7) корректно описывает рассеяние электронов при числе столкновений не менее 30 - 40 /16/, в программе принято, что электрон не изменяет направление движения, если вблизи границы образца он испытал менее 10 столкновений, число которых определяется по формуле (6). I9

3.18. В соответствии с распределением (12) разыгрывается значение ионизационных потерь энергии ΔE_4 , испытываемых электроном при прохождении слоя. Учитываются резонансные эффекты 117), (20) и моляризация среды (21);

3.19. По формулам (22) и (23) вычисляются радиационные потери энергии электрона $\Delta \mathcal{L} \rho$;

3.20. Определяется энергия электрона Е. на выходе из слоя

 $E_{i+i} = E_i - \Delta E_u - \Delta E_P. \tag{36}$

3.21. Вычисляются ксординаты и направление движения электрона на выходе из слоя в основной системе координат, для чего используются соотношения, полученные в разделе 2;

3.22. Пункты 3.14 - 3.21 повторяются до тех пор, пока электрон не выйдет из образца или потеряет в нем всю энергию;

В итоге. после завершения процедуры моделирования траектории частицы в образце оказываются вычисленными координаты и направление вылета электрона из образця, а также его энергия $\Delta <$.

3.23. На основе данных о форме и размерах детектора определяются координаты и направление скорости электрона в точке вхождения в детектор. Электроны, не попавшие в детектор, подсчитываются;

3.24. Рассчитывается коэффициент отражения $\mathcal{J}(\mathcal{E}_{\kappa}, \partial_{\kappa})$ электрона с энергией \mathcal{E}_{κ} от детектора при угле падения, определенного в 3.23. Расчет осуществляется по методике, изложенной в 1.4. Затем разыгрывается случайное число, равномерно распределенное в интервале [0, 4]. Если это число меньше значения $\mathcal{Y}(\mathcal{E}_{\kappa}, \partial_{\kappa})$, электрон считается отразиввимся от детектора под углом, равным углу падения, и при попадании в образец его трасктория прослеживается опять согласно 3.13 - 3.23. Если случайное число больше $\mathcal{Y}(\mathcal{E}_{\kappa}, \partial_{\kappa})$, электрон считается попавшим в детектор и оставившим в нем энергию \mathcal{E}_{κ} . Траектория электрона в детекторе не моделируется.

3.25. На основе заданной в 3.7 функции отклика детектора разыгрывается амплитуда импульса, соответствующая оставленной в детекторе энергии \mathcal{E}_{\varkappa} . Затем по калибровочной зависимости из 3.8 определяется номер канала амплитудного спектра, в котором будет зарегистрировано рассматриваемое событие.

· ····

Процедура моделирования полностью повторяется 17 раз по заданному числу излученных электронов.

В программе предусмотрено представление следующей информации;

- количество электронов, зарегистрированных детектором, отразившихся от детектора;

- числа электронов, не достигших образца, не вышедших из образца, не попавших в детектор;

- энергетическое распределение электронов, зарегистрированных детектором, а также полученный из него с учетом функции отклика детектора амплитудный спектр;

- угловое распределение электронов, вышедших из образца.

4. Проверка программы

Проверка программы осуществлялась путем моделирования угловых и энергетических распределений электронов, полученных на образцах с разными \mathcal{X} и толщинами, а также при различной энергии /17 - 20/.

На рис. З точками показаны экспериментальные угловые распределения электронов с начальной энергией E_0 после прохождения через фольги из алюминия (100 мг/см² – E_0 = 1,0 МэВ) /18/, меди (51,1 мг/см² – E_0 = 1,75 МэВ) /17/, золота (370 мг/см² – E_0 =2,5 МэВ) /18/. Результаты моделирования представлены на этом же рисунке в виде гистограмм. На рис. 4 приведены экспериментальные и расчетные энергетические спектры электронов, прошедших через слои алюминия (100 мг/см² – E_0 = 1,0 МэВ) и эолота (150 мг/см² – E_0 = 1,0 МэВ, 370 мг/см² – E_0 = 2,5 МэВ). Изметения выполнены в /18/. И наконец, на рис. 5 изображены спектры электронов, прошедших через образцы алюминия значительно меньшей толщины: 4,42 мг/см² – E_0 = 481,7 и 975,7 кэВ /20/; 8,8 мг/см² – E_0 = 624 кэВ /19/. На всех рисунках указаны интервалы углов вылета Θ , в пределах которых электроны попадают в образец. Рис. 3 – 5 демонстрируют хорошую согласованность результатов моделирования с экспериментальными данными.

Таким образом, разработанная программа позволяет рассчитывать угловые и энергетические распределения электронов, прошедших через слои вещества, в гостаточно широком диапазоне толщин и атомных номеров поглотителей. Программа может быть использована при планировании и проведении исследований 25 -распада атомных ядер с целью оптимизации применяемых экспериментальных методик и для обработки результатов измерений. يات بر من ماريا ماريان ماريني ، دورونونوي <mark>ماريا ماريان ماريان ماريان ماريان ماريان ماريان م</mark>اريان ماريان ماريان م

|:



Рис. З. Угловые распределения электронов, прошедших через фольги из алюминия, меди и золота

222



Рис. 4. Энергетические спектры электронов на выходе из образнов алюминия и золота. Жирная линия - эксперимент . тонкая - расчет

. .

2

hain of

for the second second



Рис. 5. Энергетические спектры электронов после прохождения алюминиевых фольг. Жирная линия – эксперимент, тонкая – расчет

1.Moliere G. Theorie der Streuung schneller geladener. Teilchen I.Einzelstquung am abgeschirmten Coulomb-Feld. -2.Naturf., 1947, v.2a.p. 133-145. Moliere G. Theorie der Streuung schneller geladener. Teil-

chen II. Mehrfach- und Vielfachstreuung. -Z.Naturf., 1948, v.3a,p.78-97.

- 2.Goudsmith S.A., Saunderson J.L. Multiple Scattering of Electrons. - Phys. Rev., 1940, v. 57, p. 24-29, 1940, v. 58, p. 36-42.
- 3.Bethe H.A. Molier's Theory of Kultiple Scattering. -Phys.Rev., 1953, v.89, p. 1256-1266.
- 4.Yang C.N. Actual Path Length of Electrons in Foils. -Phys. Rev., 1951, v.84, p.599-600.
- 5. Ландау Л.Д. О потерях энергии быстрыми частицами на ионизацию. - Собрание трудов, т.І, М., Наука, 1969, с. 482-490
- 6.Borsch-Supan W. On the Evaluation of the Function $\gamma = \frac{1}{2\pi i} \int_{e^{-\frac{1}{2\pi i}}} e^{-\frac{1}{2\pi i}} du$ for Real Values of λ . -J.Res.Natl.Bur.Standarts, 1961, v.65B, p.245-250.
- 7. Tabata T., Ito R. Approximations to Landau's Distribution Functions for the Ionization Energy Loss of Fast Electrons. -Nucl.Instrum. and Methods, 1979, v. 158, p. 521-523.
- 8.Blunck O., Leisegang S. Zum Energieverlust schneller Electronen in dunnen Schichten. -Z. Physik, 1950, v. 128, p. 500-505.

14

9. Findlay D.J.S., Dusautoy A.R. Improvements to the Blunck-Leisegang Energy Loss Straggling Distribution. - Mucl. Instrum. and Methods, 1980, v. 174, p. 531-533.

10. Sternheimer R.M. The Density Effect for the Ionization Loss in Various Materials. -Phys.Rev., 1952, v.88, p.851-859.

- 11.Sternheimer R.M., Berger M.J., Seltzer S.M. Density Effect for the Ionization Loss of Charged Particles in Various Substances. -At.Data Nucl.Data Tables, 1984, v. 30, p. 261-271.
- 12.Seltzer S.M., Berger M.J. Procedure for the Calculating the Radiation Stopping Power for Electrons. -Int.J.Appl. Radiat.Isot., 1982, v. 33, p. 1219-1226.
- 13.Kuzminikh V.A., Vorobiev S.A. Backscattering Coefficients
 Calculation of Monoenergetic Electrons and Positrons.
 -Nucl.Instrum. and Methods, 1975, v. 129, p. 561-563.
- 14. Tabata T., Ito R., Okabe S. An Empirical Equation for the Backscattering Coefficients of Electrons. -Nucl.Instrum. and Methods, 1971, v.94, p. 509-513.
- 15.Grosswendt B., Waibel E. Determination of Detector Efficiencies for Gamma Ray Energies up to 12 Mev. II. Monte Carlo Calculations. -Nucl.Instrum. and Methods, 1975, v.131, p. 143-156.
- 16.Vande Putte D.W. Assessment of the Capabilities of Monte Carlo Electron Transport Models Using the Continuous Slowing Down Approximation. -Nucl.Instrum. and Methods, 1982,v.203,p.367-375.
- 17.Frank H. Zur Vielfachstreuung und Ruckdiffusion schneller
 Elektronen nach Durchgang durch dicke Schichten.
 -Z.Naturf., 1959, v. 14a, p. 247-261.
- 18.Rester D.H., Derrickson J.H. Electron Transmission Measurements for Al, Sn and Au Targets at Electron Bombarding

Energies of 1.0 and 2.5 Mev. -J.Applied Physics, 1971, v.42, N2, p.714-721.

- :, Spalek A. Energy and Angular Distributions of Electrons Emitted from Spectrometer Sources: Monte Carlo Calculations. -Nucl.Instrum. and Methods, 1982, v. 198, p. 399-402.
- 20. Ц.Вылов и др. О чувствительности эксперимента по ноиску двойного безнейтринного бета-распеда с помощью ШД.
 Препринт ОИЯИ, Р6-84-554, Дубна, 1984.

Рукопись поступила в релакимонную группу 01.10.86 г.

tin statistical and statistic and statistic statistic statistics of the statistic statistics and the statistic

Юрий Георгиевич Здесенко Влацимир Ильич Третяк

РАСЧЕТ ПО МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО УТЛОВЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЭЛЕКТРОНОВ, ПРОШЕДШИХ ЧЕРЕЗ СЛОИ ВЕЩЕСТВА (программа TRACK)

> Редакторы: Л.П.Малашкина Н.А.Солдатенко

> > and the second second

 Поднисано к печати
 3.12.86 г.

 БФ 27790
 Бумага офсетная
 Усл.-печ.л.-1,75

 Изд. ЖИНИ-86-43
 Печать офсетная
 Уч.-изд.л. -0,8

 Тип.заказ № 44
 Формат бумаги 60х90/16
 Тираж 200 экз. '

СКТБ с ЭП Института ядерных исследовений АН УССР 252028, Киев--28, проспект Науки, IIЭ